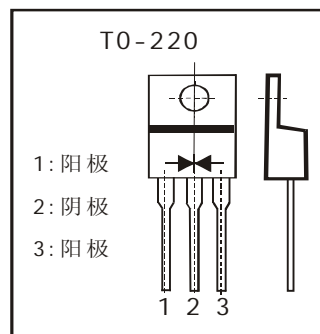


## 肖特基二极管—MBR1060CT

### 1、特征

- 半桥整流、共阴结构
- 多层金-半硅势垒结构，多数载流子导电
- 低功耗，高效率
- 用于低压高频逆变电路，续流电路和保护电路
- 带过压保护环
- 封装型式：T0-220-3L



### 2、性能指标

极限值：（除其他标注外 $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ）

参数	符号	数值	单位
最大反向重复峰值电压	$V_{RRM}$	60	V
反向峰值工作电压	$V_{RWM}$	60	V
最大直流阻断电压	$V_{DC}$	60	V
$T_{amb} = 105^{\circ}\text{C}$ 整个器件最大正向平均整流电流	$I_{F(AV)}$	10	A
正向峰值浪涌电流（额定负载8.3ms半正弦波—按JEDEC方法）	$I_{FSM}$	175	A
反向重复峰值浪涌电流 $t_p = 2.0 \mu\text{s}, 1\text{KHZ}$	$I_{RRM}$	1	A
工作结温和储存温度范围	$T_J, T_{STG}$	-40 ~ 175	$^{\circ}\text{C}$

热性能（除其他标注外 $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ）

参数	符号	数值	单位
从结到每只管脚的典型热阻	$R_{\theta JC}$	4	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

电性能 (除其他标注外  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ )

参数	符号	数值	单位
最大正向瞬态峰值压降 $I_F=5\text{A}$ , $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$	$V_F$	0.65	V
最大反向瞬态电流 $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ 额定直流阻断电压时 $T_{amb} = 105^{\circ}\text{C}$	$I_R$	1 50	mA